09 日本国特許庁 (JP)

①実用新案出願公開

⑫ 公開実用新案公報 (U)

昭55—22140

©Int. Cl.³ H 01 L 21/205 C 30 B 25/12 H 01 L 21/223 21/31 識別記号

庁内整理番号 - 7739—5F 6703—4G 6684—5F 7377—5F 母公開 昭和55年(1980)2月13日

審査請求 未請求

(全 3 頁)

匈半導体基体の加熱支持台

②実 願 昭53-104411

②出 願 昭53(1978) 7月28日

⑩考 案 者 伊藤博之

伊丹市瑞原 4 丁目 1 番地三菱電

の実用新案登録請求の範囲

- (1) 半導体基体の支持面を凹形に形成して、この 半導体基体を下面周線、周辺部の一部もしくは 全部で支持面上に載置させて、少なくとも下面 中央部が支持面に直接触れないようにしたこと を特徴とする半導体基体の加熱支持台。
- (2) 半導体基体の支持面を、この半導体基体の外 径を含む範囲内で次第に傾斜する傾斜面とした ことを特徴とする実用新案登録請求の範囲第1 項記載の半導体基体の加熱支持台。
- (3) 半導体基体の支持面を、この半導体基体の外 径を含む範囲内で次第に傾斜する傾斜面と、同 外径よりも小径の平面とによる凹形に形成した ことを特徴とする実用新案登録請求の範囲第1 項記載の半導体基体の加熱支持台。
- (4) 半導体基体の支持面を、この半導体審体の外

機株式会社北伊丹製作所内

切出 願 人 三菱電機株式会社

東京都千代田区丸の内2丁目2

番3号

四代 理 人 弁理士 葛野信一 外1名

っつ段部支持面

経を含む範囲内で中央に凹面をもつ段部支持面 としたことを特徴とする実用新案登録請求の範 囲第1項記載の半導体基体の加熱支持台。 図面の簡単な説明

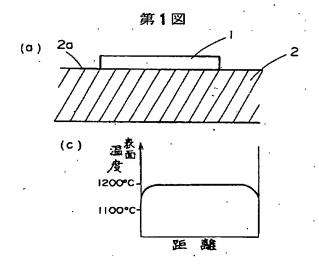
第1図a,b,cないし第3図は従来の加熱支持台の各例による断面と、その半導体基体の表面 温度分布を示す説明図、第4図a,bないし第6 図a,bはこの考案に係わる加熱支持台の各別の 実施例による構成断面と、その半導体基体の表面 温度分布を示す説明図である。

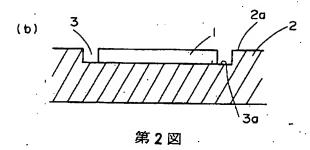
11 ······半導体基体、11 a ······下面周線部、

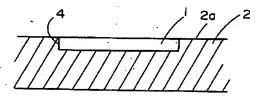
11b……下面中央部、11c……下面周辺部、

1 2 ······ 加熱支持台、1 2 a ······ 傾斜面、

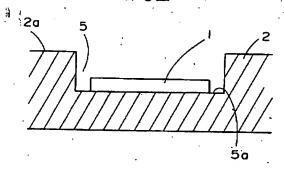
12 b ······平面、12 c ······段部支持面、12 d ·······凹面、12 e ·······傾斜面、13 ······空間。



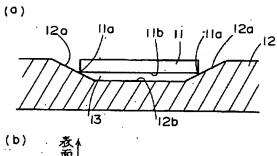


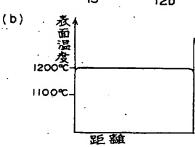


第3図

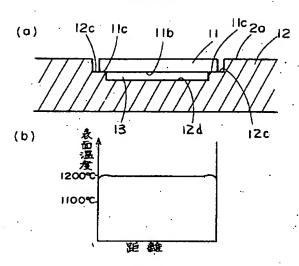


第4図









第6図

